

Выписка
из протокола № 4 от 26 июня 2015 г.
заседания диссертационного совета Д 002.231.01 на базе ИРЭ им.
В.А.Котельникова РАН

Присутствовали: 20 членов совета из 25.

Председатель: д.ф-м.н., профессор, академик Ю.В.Гуляев

Ученый секретарь: д.ф-м.н., доцент И.Е.Кузнецова

Повестка дня:

2. Прием к защите диссертации **Клочкова** Алексея Николаевича на тему: «Электронный спектр в модулированно-легированных гетероструктурах InGaAs/InAlAs на подложках GaAs и InP» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 «Физика полупроводников»

Научный руководитель: Галиев Галиб Бариевич, доктор физико-математических наук, зав. лабораторией № 101 «Лаборатория исследования процессов формирования низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах соединений АЗВ⁵» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН (ИСВЧПЭ РАН).

§ 2.

Слушали:

О приеме к защите диссертации **Клочкова** Алексея Николаевича на тему: «Электронный спектр в модулированно-легированных гетероструктурах InGaAs/InAlAs на подложках GaAs и InP» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 «Физика полупроводников»

Диссертация выполнена в лаборатории № 101 «Лаборатория исследования процессов формирования низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах соединений АЗВ⁵» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН).

- В работах, опубликованных диссертантом, полностью содержатся материалы диссертации.

По теме диссертации опубликовано 13 работ, из них 7 статей - в журналах, входящих в Перечень изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 статья – в зарубежном рецензируемом журнале, реферируемом в базах данных Scopus и Web of Science, 5 работ - в сборниках трудов всероссийских и международных конференций.

Соискатель выполнил теоретические расчеты электронного спектра гетероструктур, провел анализ и интерпретацию спектров фотолюминесценции исследованных гетероструктур. Он также принимал участие при планировании и проведении экспериментальных работ по эпитаксиальному росту гетероструктур в лаборатории исследования процессов формирования низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах соединений АЗВ⁵ ИСВЧПЭ РАН

(зав. лаб. д.ф.-м.н. Г.Б. Галиев), определению концентрации и подвижности электронов, измерению спектров фотолюминесценции.

Докл.: д.ф.-м.н., В.А.Саблик

Постановили:

1. Принять к защите диссертацию **Клочкова** Алексея Николаевича на тему: «Электронный спектр в модулированно-легированных гетероструктурах InGaAs/InAlAs на подложках GaAs и InP» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 «Физика полупроводников»

2. Официальными оппонентами утвердить:

- **Капаева Владимира Васильевича** – доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Отделения физики твердого тела ФГБУН Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, специальность 01.04.21 – Лазерная физика.

- **Кытина Владимира Геннадьевича** – кандидата физико-математических наук, доцента кафедры физики низких температур и сверхпроводимости Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность 01.04.09 – Физика низких температур.

3. Ведущей организацией утвердить:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники», (факультет электроники), (г. Москва).

4. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.

5. Установить дополнительный список адресов для рассылки автореферата (см. аттест. дело А.Н.Клочкова).

6. Дату защиты назначить на «09» октября 2015 г., в 10-00.

Решение принято единогласно.

Выписка из протокола № 4 от 26.06.2015 г. верна:

Ученый секретарь диссертационного совета

доктор физ.-мат.наук , доцент



И.Е.Кузнецова